

Facteurs de procédé type	Gaz i											
	CF ₄	C ₂ F ₆	CHF ₃	CH ₂ F ₂	C ₃ F ₈	o-C ₄ F ₈	NF ₃ Isolé	NF ₃	SF ₆	C ₆ F ₆ ^a	C ₅ F ₈ ^a	C ₆ F ₁₀ O ^b
Etch 1-U ₁	0,7	0,4 ¹	0,4 ¹	0,06 ¹	S. O.	0,2 ¹	S. O.	0,2	0,2	0,1	0,2	S. O.
Etch PCF ₄	S. O.	0,4 ¹	0,07 ¹	0,08 ¹	S. O.	0,2	S. O.	S. O.	S. O.	0,3 ¹	0,2	S. O.
Etch PC ₂ F ₆	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,2	S. O.	S. O.	S. O.	0,2 ¹	0,2	S. O.
CVD 1-U ₁	0,9	0,6	S. O.	S. O.	0,4	0,1	0,02	0,2	S. O.	S. O.	0,1	0,1
CVD PCF ₄	S. O.	0,1	S. O.	S. O.	0,1	0,1	0,02 ²	0,1 ²	S. O.	S. O.	0,1	0,1
CVD PC ₂ F ₆	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,4

¹ Estimation comprenant les procédés de gravure à gaz multiples.

² Estimation reflétant les procédés de gravure à gaz multiples à faible teneur en potassium et en carbure qui peuvent contenir des additifs de gaz à effet de serre fluorés carbonatés.